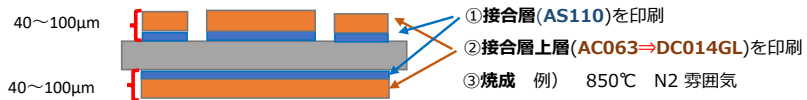


| 型番      | 形成膜厚     |          | 用途                              | 特徴                           | 成分       | 接着強度<br>(N/2mm <sup>2</sup> ) | 推奨焼成条件<br>(窒素雰囲気下) | 塗布方法    | 対応基板                  |
|---------|----------|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
|         | 100 μm未満 | 100 μm以上 |                                 |                              |          |                               |                    |         |                       |
| AS110   | ○        | ○        | 厚膜導体配線、電極の形成<br>(セラミックス基板との接着層) | 高い接合強度<br>高温環境下での高い耐久性(熱信頼性) | Ag,Cu,Ti | ≥ 30                          | 850 °C 10min       | スクリーン印刷 | Al2O3<br>AlN<br>Si3N4 |
| AC063   | ○        | ○        | 厚膜導体配線、電極の形成<br>(AS110の上層積層用)   | 上下層導体膜の繋ぐ役                   | Ag,Cu    | -                             |                    | スクリーン印刷 | Al2O3<br>AlN<br>Si3N4 |
| DC014GL | ○        | ○        | 厚膜導体配線、電極の形成<br>(AC063の最上層に使用)  | 高い表面平滑性<br>1回の印刷でより大膜厚の形成が可能 | Cu       | -                             |                    | スクリーン印刷 | Al2O3<br>AlN<br>Si3N4 |
| GL39    | —        | ○        | 超厚膜導体配線、電極の形成<br>(積層増膜用)        | 1回の印刷でより大膜厚の形成が可能            | Cu       | -                             | 800 °C 10min       | スクリーン印刷 | Al2O3<br>AlN<br>Si3N4 |

※使用例

膜厚100μm未満の場合



100μm以上積層する場合、  
右記の工程を追加

膜厚100μm以上の  
場合

